



## بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسی مقاله :

منبع سیلیسید مکمل MOSFET /بدنه نازک درین برای رژیم با

طول گیت 20 نانومتر

عنوان انگلیسی مقاله :

Complementary silicide source/drain thin-body MOSFETs  
for the 20nm gate length regime



### توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.



## بخشی از ترجمه مقاله

### Conclusion

Complementary thin-body silicide source/drain devices with excellent turn-off characteristics have been demonstrated down to 15nm gate-length. Source/drains are fabricated from PtSi and ErSi<sub>1.7</sub> for PMOS and NMOS respectively. A simple transmission model fits device data and predicts that ballistic current levels can be obtained with the use of a 20Å oxide and 3E19 cm<sup>-3</sup> extension doping.

### نتیجه گیری

مکمل سیلیسید بدنه نازک دستگاه های سورس / درین با ویژگی های خاموش عالی با طول گیت 15 نانومتر نشان داده شده است. منبع / درین PtSi و ErSi<sub>1.7</sub> برای PMOS و NMOS به ترتیب ساخته شده است. مدل انتقال ساده متناسب با دستگاه داده ها و سطح فعلی بالستیک را می توان با استفاده از یک اکسید 20Å و  $3E19 \text{ cm}^{-3}$  پیش بینی کرد و بدست آورد.



### توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

برای جستجوی جدیدترین مقالات ترجمه شده، [اینجا](#) کلیک نمایید.